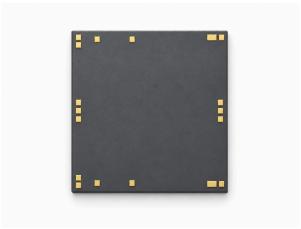
Die de amplificador de potencia GaN MMIC de 10000–13000 MHz

LCI-PA-10000-13000-PS45T es un amplificador de potencia GaN MMIC en formato de die sin encapsular para 10000–13000 MHz. Admite funcionamiento en CW y pulsado.



Valores de la tabla RF: Potencia de salida saturada: 45 dBm (típico); Ganancia de potencia: 20 dB (típico); Eficiencia de potencia añadida: 40 % (típico). Condiciones de ensayo RF: TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V. Dimensiones del die: 3.3 × 3.5 × 0.1 mm.

Características RF

TA = +25 °C; Vd = +28 V; Vg = -2.6 V

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Frecuencia de funcionamiento	f	10000	-	13000	MHz
Potencia de salida saturada	Psat	-	45	-	dBm
Ganancia de potencia	Gp	-	20	-	dB
Planitud de la ganancia de potencia	ΔGp	-	±0.3	-	dB
Eficiencia de potencia añadida	PAE	-	40	-	%

Polarización DC y corrientes

TA = +25 °C

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidad
Tensión de drenador	Vd	24	28	30	V
Tensión de puerta	Vg	-3.1	-2.6	-2.4	V
Corriente de drenador en reposo	Id	-	0.7	-	A
Corriente dinámica de drenador	Idd	-	3.3	-	A
Corriente dinámica de puerta	Igg	-	-	2	mA

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Tensión drenador-fuente máxima	Vd	-	-	30	-	V
Polarización de puerta mínima	Vg	-5	-	-	-	V
Potencia de entrada máxima	Pin	-	-	28	-	dBm
Temperatura máxima del canal	Top	-	-	225	-	°C

Valores límite

Valores límite; no son consignas de funcionamiento normal.

Parámetro	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Valor	Unidad
Temperatura de almacenamiento	TSTG	-65	-	150	-	°C
Tolerancia a desadaptación de carga	-	-	-	-	3:1	-

Dimensiones del chip

Parámetro	Valor	Unidad
Dimensiones del die	3.3 × 3.5 × 0.1	mm
Tolerancia del contorno en planta	±50 (Solo contorno en planta; no se especifica la tolerancia del espesor.)	µm

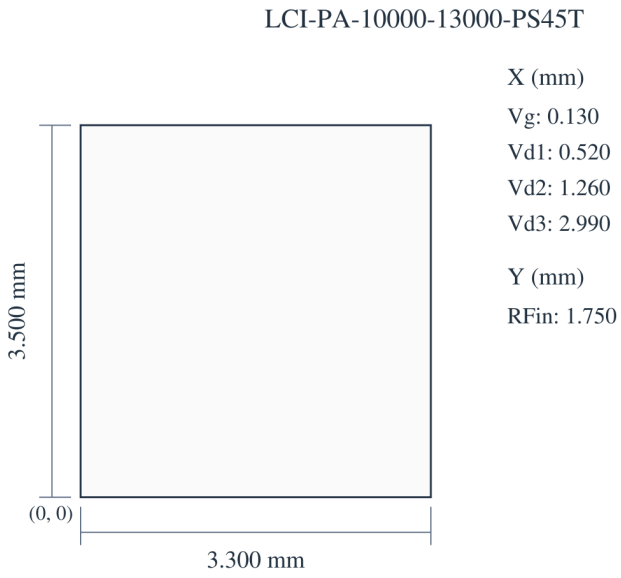
Registro de la publicación actual · 1.6 · 2026-11-12. Actualización de la descripción o del contenido editorial. Sustituye a la revisión 1.5.

Integración del chip y secuencia de polarización

Al encender, aplicar la polarización de puerta antes que la de drenador. Al apagar, retirar primero la del drenador. Manipular en un entorno limpio con protección ESD y utilizar un soporte con expansión térmica compatible con el die de SiC.

Plano dimensional mecánico

Contorno y coordenadas acotadas en mm. Este plano sirve como referencia dimensional. Para la fabricación y el conexionado por hilo se requieren planos completos.



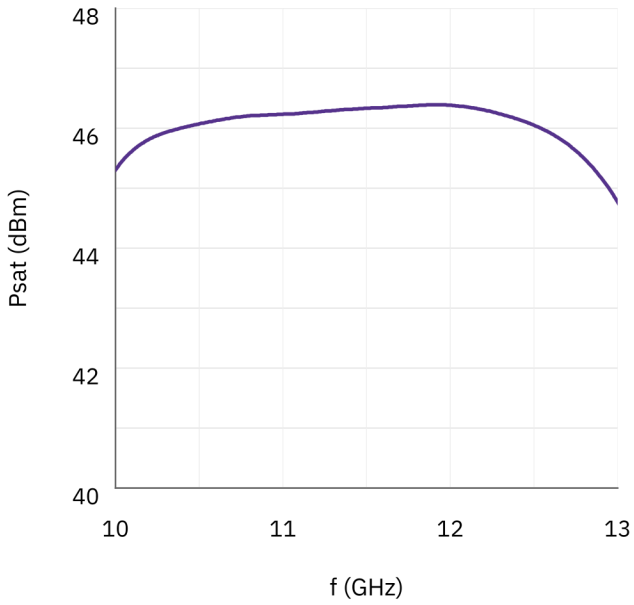
3.300 × 3.500 × 0.100 mm
X, Y: ±0.050 mm
X → · Y ↑ · X, Y: mm

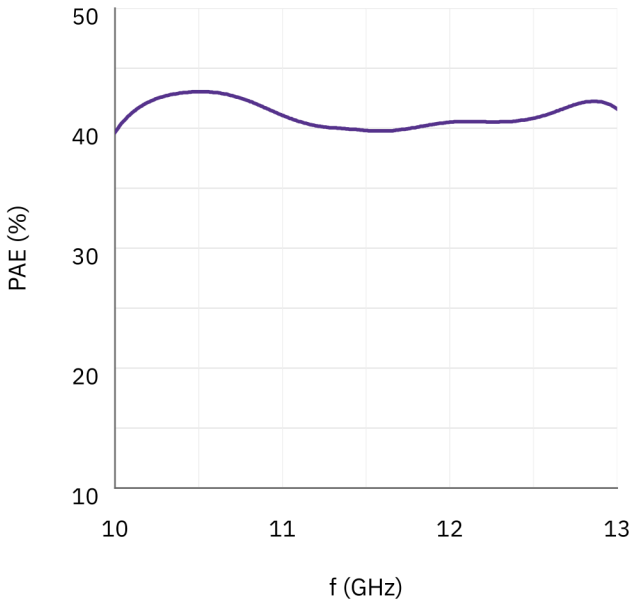
Curvas de rendimiento

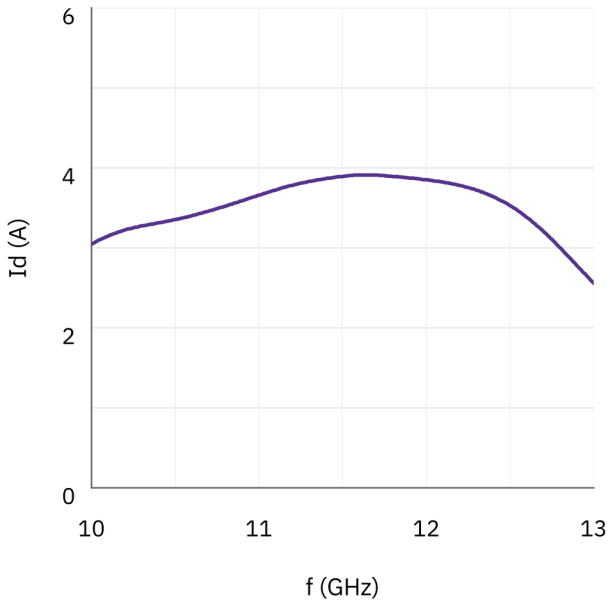
Cada gráfica de rendimiento corresponde a las condiciones de funcionamiento que indica.

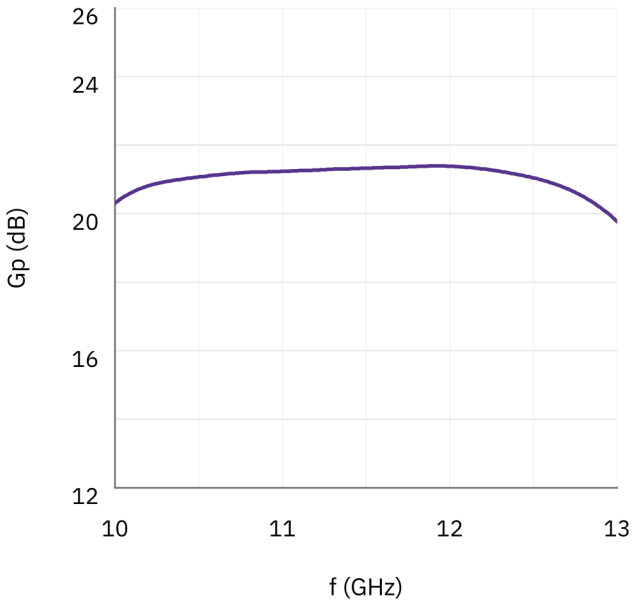
Pulsado — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Ganancia de potencia.

Notas de la figura: Vd=+28V; Vg=-2.6V. Pin = 25 dBm. Ancho de pulso = 100 µs; ciclo de trabajo = 10%. Las lecturas son aproximadas.



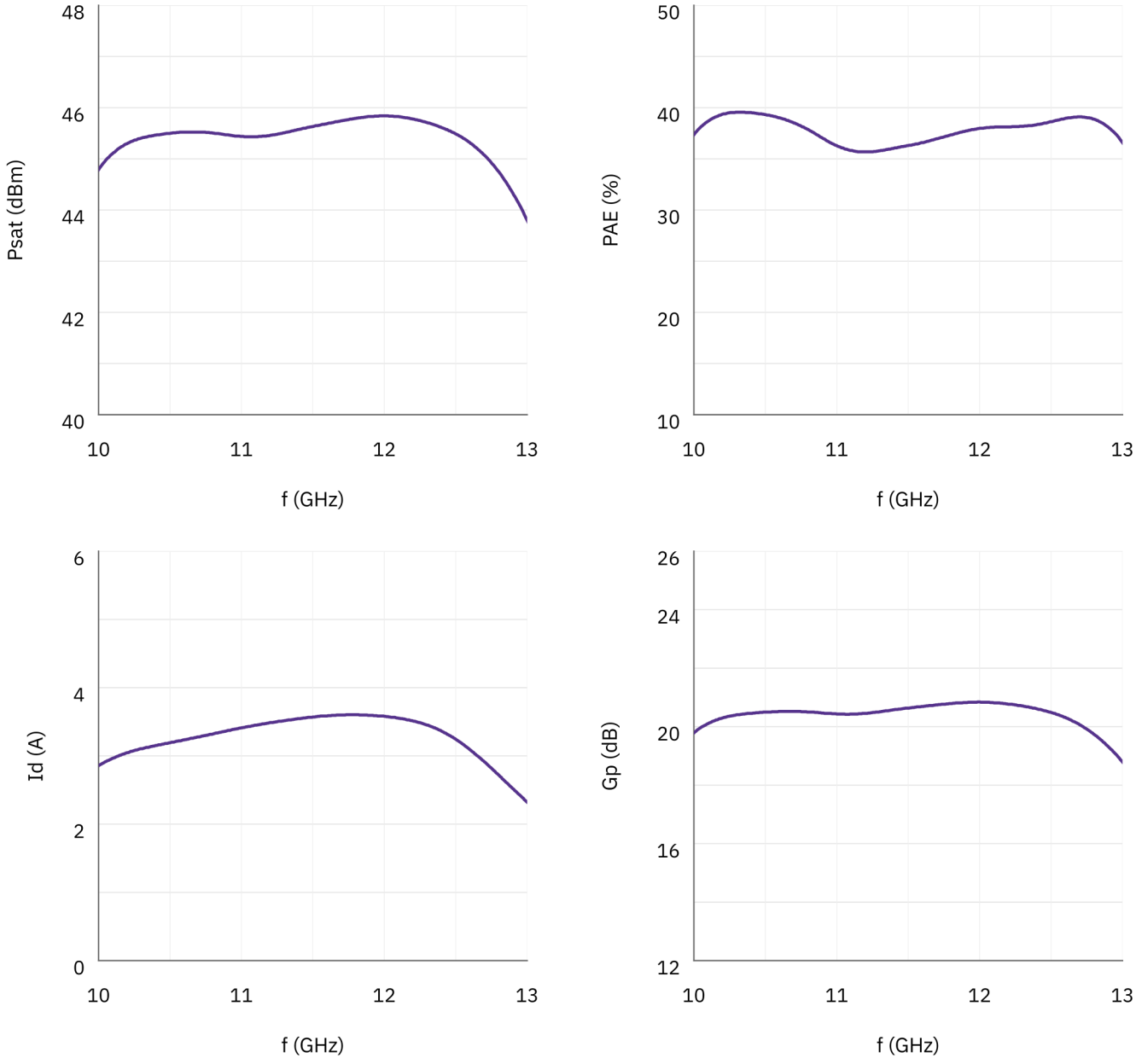






Onda continua (CW) — Potencia de salida saturada; Eficiencia de potencia añadida; Corriente dinámica de drenador; Ganancia de potencia.

Notas de la figura: Vd=+28V; Vg=-2.6V. Pin = 25 dBm. Las lecturas son aproximadas.



Aviso del documento

Las especificaciones pueden revisarse. Antes de cerrar el diseño, confirme con LCRF la revisión vigente y los requisitos específicos del producto. La oferta aprobada y la documentación del pedido definen la configuración suministrada.